

⑩日本国特許序 (JP) ⑪特許出願公開
 ⑫公開特許公報 (A) 平3-48421

⑬Int.Cl.

H 01 L 21/302
21/205
21/31

差別記号

C 8223-5F
7739-5F
C 6940-5F

府内整理番号

⑭公開 平成3年(1991)3月1日

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全7頁)

⑮発明の名称 プラズマ処理方法

⑯特 願 平2-102536

⑰出 願 平2(1990)4月18日

優先権主張

⑱平1(1989)4月18日⑲日本(JP)⑳特願 平1-99068

⑳発明者 小島 弘 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 東京エレクトロン株式会社内

㉑発明者 田原 好文 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 東京エレクトロン株式会社内

㉒発明者 新井 泉 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 東京エレクトロン株式会社内

㉓出願人 東京エレクトロン株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

明細書

1. 発明の名称

プラズマ処理方法

2. 特許請求の範囲

(1) プラズマ処理装置内の載置台上に被処理体を載置し、この被処理体を温調するために載置台を冷却してプラズマ処理を行うにあたり、

プラズマ処理時以外の期間の少なくともプラズマ処理ガス換気開始時に、上記プラズマ容器内に不活性ガスを導入することを特徴とするプラズマ処理方法。

(2) プラズマ処理容器内に導入される不活性ガスを、載置台表面に吹き付けるようにしたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のプラズマ処理方法。

3. 発明の詳細な説明

プラズマエッティング装置のようなプラズマ処理装置は、プラズマ処理容器内に上部電極及び下部電極を対向配置している。そして、下部電極を設置台としてその上に被処理体を支承するようになっている。そして、プラズマ処理容器内にエンチングガスを導入すると共に、上部電極、下部電極間にRFパワーを印加し、エンチングガスのプラズマを誘起している。そして、このプラズマ内で生成されたラジカルによる化学的反応エッティングと、プラズマ中で生成されたイオンを電極間の電界に沿って加速した加速イオンによる物理的エッティングとによって、被処理体をエッティング処理していた。

この場合、良好なエッティング特性を確保するため、被処理体を支持する下部電極を例えば液体の槽液によって冷却して、被処理体の温度を一定に保つ。

特許登録請求書

本発明は、「プラズマ処理方法」に関するもの

(従来の技術)

本発明は、「被処理体を支持する下部電極を液体の槽液によって冷却して、被処理体の温度を一定に保つ

特開平3-48421 (2)

そして、一定の真空状態を保つて次のプロセスの開始時まで待機するようにしていた。

このようなプラズマエッティング装置は、エッチングガスをプラズマ状態とする。そして、エッチングガスは分解され反応生成物（デポジション）が生成される。この場合、プラズマエッティング処理が終了した後の真空引き開始直後に、プラズマ処理容器内には真空引きによる気体の流れが生じる。そして、反応生成物はこの流れに沿って排気される。

〔発明が解決しようとする課題〕

しかしながら、プラズマ処理容器内の真空状態が一定値になると、プラズマ処理容器内の気体の流れがなくなる。この結果、生成された反応生成物は、プラズマ処理容器内に停滞した状態となる。

このプラズマ処理容器内に停滞している反応生成物は、処理容器内の冷却された箇所で気化し、その部分に吸着する。特に、プラズマ処理が終了し、かつ、処理の終了した被処理体が下部電極か

ら取り出され後には、下部電極が上述したように液化等によって所定温度に冷却されている。このため、プラズマ処理容器内に停滞している反応生成物の多くが下部電極上の被処理体載置面に付着してしまう。

このように、下部電極上に反応生成物が付着した状態で、次の被処理体をこの上に載置してプラズマエッティング処理を実施すると、次のような問題が生じる。すなわち、下部電極上に付着する反応生成物は、被処理体の載置面に凹凸を生じさせる。このため、載置される被処理体とその上方に対向配置された上部電極との対向間隔が被処理体の各位置によって相違する。この結果、エッティングレートのようなエッティング特性が、被処理体の面内で不均一になってしまう。

また、下部電極上の反応生成物が、被処理体の裏面にも付着してしまう。このため、この被処理体を次の処理工序で処理する前に、裏面側に付着した反応生成物がパーティクルの原因となり、被処理体の歩留りを低下する原因となっていた。

本発明の目的は、反応生成物が載置台の裏面に付着することを確実に防止して、被処理全体に均一性を持たせることができるプラズマ処理方法を提供することにある。

また、本発明の他の目的は、反応生成物が被処理体に付着することを確実に防止して、被処理体の高歩留りで所定の処理を施すことができるプラズマ処理方法を提供することにある。

〔発明の構成〕

〔課題を解決するための手段〕

すなわち、本発明は、プラズマ処理容器内の載置台上に被処理体を載置し、該被処理体にプラズマ処理ガスによるプラズマ処理を施す工程と、前記プラズマ処理時以外の期間の少なくともプラズマ処理ガスの廃棄期間に前記プラズマ容器内に不活性ガスを導入する工程と、を具備するプラズ

マに不活性ガスを導入している。

従って、プラズマ処理時以外の上記期間では、このプラズマ処理容器内で不活性ガスによる流れ状態を常時確保することができる。特に、所定温度に冷却されている載置台上方にもこの不活性ガスの流れを実現することができるので、この不活性ガスの流れによって反応生成物が載置台に付着するのを防止することができる。また不活性ガスを載置台裏面に吹き付けるようにすれば、この効果はさらに大きくなる。

従って、プラズマ処理に際しては、反応生成物による凹凸の少ない載置台に被処理体を載置でき、被処理体の処理特性の面内均一性が向上する。また、被処理体の裏面側に反応生成物が付着することもないので、パーティクルの原因を除去でき、被処理体の歩留りを大幅に向上することができる。

以下、本発明の実施例について反応生成物を導入する方法を示す。

本発明では、一工程処理時以外の期間、すなわちプラズマ処理ガス廃棄期間に、プラズマ処理容

器内に不活性ガスを導入する方法を示す。

特開平3-48421(3)

がない。

(実施例)

以下、本発明方法をプラズマエッティング装置に適用した実施例について、図面を参照して説明する。

第1図は、本発明方法にて使用するプラズマエッティング装置の概略構成を示す説明図である。このプラズマエッティング装置は、対向して配置された上部電極10及び下部電極30とを有している。下部電極30上には、被エッティング材である半導体ウエハ42を設置するようになっている。そして、上部電極10及び下部電極30の間に、RF電源40によって例えば380kWのRFパワーを印加するよう構成されている。上部電極10に形成された多数の孔からエッティングガスを導入し、上部電極10及び下部電極30の間の領域でプラズマを生成するようになっている。このプラズマによって、ウエハ42をエッティングするようになっている。上部電極10は、フランジ状に形成された導電性の熱伝導部材12を有している。この熱伝導部材12にRF電源40

液体Heを下部電極30の裏面側に導入するようになっている。

このような上部電極10及び下部電極30を、それぞれ平行してチャンバー内に配置することによって、平行平板型のエッティング装置が構成されている。

次に、このプラズマエッティング装置に置けられた制御系について第2図を参照して説明する。

上部電極10および下部電極30を取扱したプラズマ処理容器50の下部には、排気ポート52が設けられている。排気ポート52には、圧力調整用のA. P. C (Auto Pressure Control) パルプ54、コンダクタンスバルブ56、ターボ分子ポンプ(T. M. P) 58及びロータリーポンプ(R. P) 60がそれぞれ接続されている。また、プラズマ処理容器50に脚接続されたコードロックチャンバー62にも、バルブ54. A. P. C. T. M. P (R. P) 60が接続さ

からのケーブルが接続されている。

また、熱伝導部材12内には、穴が多數設けられた第1、第2の基盤板14a, 14bが、スペーサ16a, 16bを介して所定間隔で平行に配置されている。さらに、熱伝導部材12の開口部を覆うように、補強板18、アモルファス・カーボン電極20が積層配置されている。なお、アモルファス・カーボン20の周辺を覆うようにしてシールドリング22が置かれている。シールドリング22によって、アモルファス・カーボン電極20が、プラズマと接する開口部の形状が規制されている。

下部電極30は、円板状に突起した部分の上面部分にウエハ42を設置できるようになっている。そして、設置したウエハ42の周辺部を下部電極30に固定するために、下部電極30の周囲にはリング状のクランパー部材32が配置されている。

なお、下部電極30は接地されている。また、下部電極30を所定位置に冷却するために、第2図に示すように、冷却媒体である液体N₂の循環系34が配置されている。つまり、この循環系34によって

処理容器50内に上部電極10を介して導入できるようになっている。そして、各々のエッティングガス導入系70による供給流量は、マスフローコントローラ(M. F. C) 72によって制御可能になっている。

また、不活性ガスとして例えばN₂を導入するN₂導入系80が設けられている。この途中にもM. F. C 82が配置されている。このN₂ガスは、プロセス時以外の期間にプラズマ処理容器50内に導入できるようになっている。そして、M. F. C 82によって、プロセス時のエッティングガスの供給流量よりも、プロセス時以外のN₂ガスの供給流量を多く(例えば200~1000SCCM)設定することにより、錯逸する反応生成物の排出動作を効果的に行なうようになっている。

なお、N₂ガス導入系80の一部は、エッティングガス導入系70の一部と兼用しているが、それぞれ別個に配置しても良い。

特開平3-48421(4)

まず、上部電極10及び下部電極30の間に下部電極40からのRFパワーを印加する。そして、エッティングガス導入系70及び上部電極10を介してプラズマ処理容器50内にエッティングガスを導入する。

これにより、上部、下部電極10、30間にプラズマを誘起させる。このプラズマ中で生成したラジカルを、ウェハ42表面に付着させて化学的反応を起こしてウェハ42のエッティングを行うと共に、プラズマ中で分解したイオンを、平行平板電極間に形成される電界によって加速してウェハ42に衝突させ、ウェハ42のエッティングを行う。

このようにして平行平板型のエッティングにより、比較的サイドエッティングを抑え、異方性エッティングを行うことが可能となる。この結果、微細パターンのエッティングを実現できる。

プラズマエッティング処理が終了すると、クランパー部材32を上昇させ、ウェハ42の換気状態を解除する。次いで、下部電極30上の処理液ミキサウェハ42をハンドラー等によって支持し、これをロードロックチャンバー52内に移送する。

反応生成物が生成されてプラズマ処理容器50内に残留している。この反応生成物は、プラズマ処理容器50内の温度が最も低い箇所に付着し易くなっている。

ウェハ42が除去された後では、プラズマ処理容器50内の温度の最も低い部分は、液体Heによって冷却されている下部電極30の表面である。しかしながら、プラズマ処理時以外の時にも、プラズマ処理容器50内のN₂ガスの流れを絶えず確保している。このため、プラズマ処理容器50内に導入している反応生成物を、このN₂ガスの流れに載せて排気ポート52より排出することができる。

しかも、下部電極30の表面と対向する上方位置からN₂ガスを導入し、下部電極30表面にN₂ガスを吹き付ける。このため、このN₂ガスの流れが、下部電極30の表面を保護する保護膜として作用する。この結果、反応生成物が下部電極30の表面に付着

して、ロードロックチャンバー52内の新たなウェハ42を、プラズマ処理容器50内に搬送し、下部電極30上にセッティングし、次のプラズマエッティング処理を行う。

ここで、この実施例では、例えば第3図に示すようにタイムチャートを使って、RF出力によるエッティング処理(E)の停止に同期して、プラズマ処理時以外の時(T)に、ガス供給系によってエッティングガスの供給(G)を不活性ガスであるN₂ガスの供給(N)切り換え、エッティングガスのプラズマ処理容器50内への導入を停止すると共に、N₂導入系80によりプラズマ処理容器50内へのN₂ガスを導入を行い、かつ、これを排気ポート52を介して排気するようにしている。

このようにN₂ガスをプラズマ処理容器50内に導入し、かつ、排気を続けることによって、プラズマ処理容器50内にN₂ガスの流れを実現することができる。

この場合、プラズマエッティング工程ではプラズマによってエッティングガスが分解されるため、反

また、反応生成物を下部電極30表面に付着させない手段としては、プラズマ処理容器50内に、下部電極30の表面温度よりも低い箇所を確保するものでも良い。すなわち、例えばプラズマ処理容器50の壁面を冷却することで、この部分に反応生成物を付着させ、結果的に下部電極30表面に付着する反応生成物の量を少なくするようにしてもよい。

しかしながら、エッティング装置は、反応生成物が多く発生する他の種付け工程と異なり、なるべくクリーンな環境でのエッティングを行うことが好ましい。つまり、この実施例の方法のようにN₂ガスによって反応生成物を排出する方が管れている。さらに、下部電極30以外の箇所に反応生成物を付着させた場合には、プラズマ処理容器50の温度を温度が増すが、この本実施例の方法では、下部電極30以外の箇所にも反応生成物を付着しないので。

特開平3-18121(5)

少なくともプラズマ処理ガス廻路時間に、プラズマ処理容器に不活性ガスを導入している。つまり、プラズマ処理時以外の期間には、プラズマ処理容器内に不活性ガスによる流れ状態を常時維持することができる。特に、所定温度に冷却されている載置台上方にも、この不活性ガスの流れを作ることができる。この不活性ガスの流れによって、反応生成物が載置台に付着するのを防止することができる。また、不活性ガスを載置台表面に吹き付けるようにすれば、この効果をさらに高めることができる。

これらの結果、プラズマ処理の際に、反応生成物による凸凹の少ない載置台上に被処理体を設置することができ、被処理体表面全体での処理特性を均一なものとすることができます。また、被処理体の裏面側に反応生成物が付着するのも防止できる。このため、パーティクルの発生原因を除去して、被処理体の処理歩留りを大幅に向上することができる。

しかも、不活性ガスによって、反応生成物を常

時排出するようにしている。このため、プラズマ処理容器内に残存する不活性ガスが、次のプロセスの開始の際に、悪影響を与えることはない。

なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、要旨の範囲内で種々の変形実施が可能である。

また、本発明は、被処理体を設置する載置台を冷却してプラズマ処理を行うプラズマエッティング以外のプラズマ処理にも同様に適用でき、例えばプラズマCVD等でも好適なものである。

また、不活性ガスとしては、N₂以外のガスを採用できることは勿論である。

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によればプラズマ処理時以外の期間の少なくとも処理ガスの廻路している構造に、プラズマ処理容器内に不活性ガスを導入することにより、プラズマ処理容器内の反応生成物が温度の低い部分に付着することを防止できる。

この結果、被処理体の処理特性の面内均一性が

向上できる。また、被処理体の裏面に反応生成物が付着する所以ないので、パーティクルの発生を抑制して、処理の歩留まりを向上することができる。

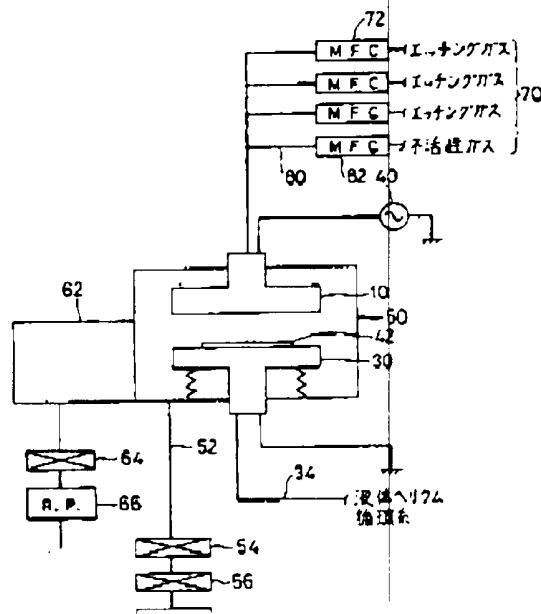
しかも、不活性ガスを用いているので、次のプロセスに悪影響を与えることがない。

4. 図面の簡単な説明

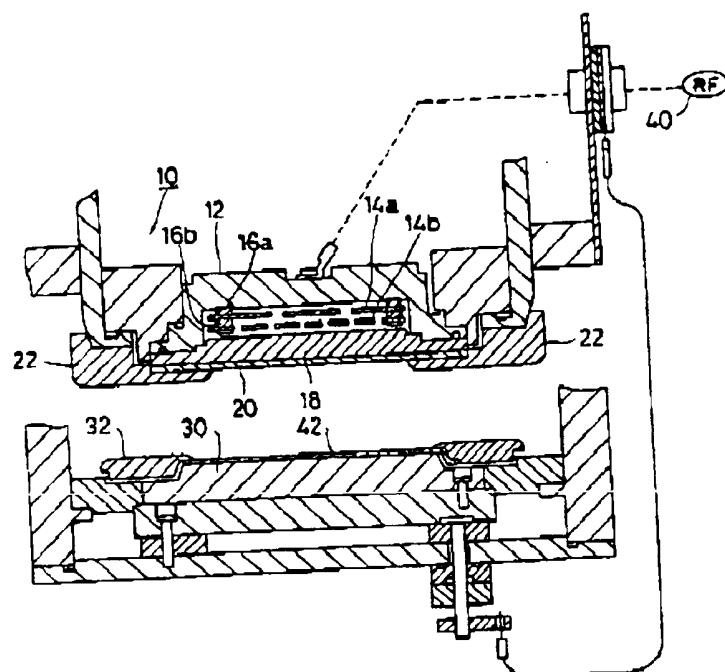
第1図は本発明方法の実施例を説明するためのプラズマエッティング装置の処理容器内構成説明図、第2図は第1図を用いたエッティング装置の構成図、第3図は第1図及び第2図のガス供給操作を説明するための放送図である。

30…載置台

特許出願人 東京エレクトロン株式会社



特開平3-48421(6)



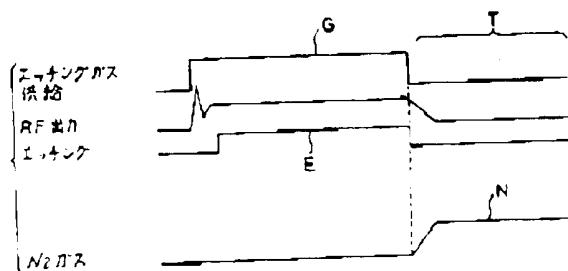
第 1 図

手続補正書

2.6.8
年 月 日
平成

通

特許庁長官



第 3 図

1. 事件の表示
平成2年特許願第102536号2. 発明の名称
プラズマ処理方法3. 補正をする者
事件との関係 特許出願人
住所 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号
名前 東京エレクトロン株式会社
代表者 小高敏夫4. 補正の対象
明細書の発明の詳細な説明の欄

特開平3-48421(7)

5. 補正の内容

- (1)明細書第2頁第15行目乃至第16行目
「液体He」を「冷媒」と補正する。
- (2)明細書第3頁第18行目
「気化」を「蓄合、固化」と補正する。
- (3)明細書第4頁第2行目
「液He」を「冷媒」と補正する。
- (4)明細書第8頁第19行目
「である液体He」を削除する。
- (5)明細書第9頁第1行目
「液体He」を「常媒」と補正する。
- (6)明細書第9頁第19行目
「CCDI.」を「CCI.」と補正する。
- (7)明細書第13頁第6行目
「液体He」を「冷媒」と補正する。